



\* 1N 3496 → 1N 3500

VOLTAGE REFERENCE DIODES (TEMPERATURE COMPENSATED)  
 DIODES DE RÉFÉRENCE DE TENSION (COMPENSÉES EN TEMPÉRATURE)

EPI Z<sup>®</sup>

59C 02540 D T-11-07

\*Preferred device  
 Dispositif recommandé

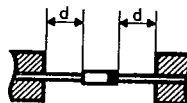
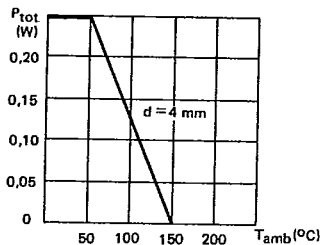
Semiconductor material : silicon  
 Matériau semiconducteur : silicium  
 Technology : local epitaxy + guard ring  
 Technologie : épitaxie localisée + anneau de garde  
 Cooling : by convection and conduction  
 Refroidissement : par convection et par conduction

V<sub>ZT</sub> (I<sub>ZT</sub> = 7,5 mA) 6,2 V ± 5 %  
 P<sub>tot</sub> (T<sub>amb</sub> = 50 °C) 0,25 W

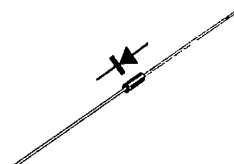
Absolute ratings (limiting values)  
 Valeurs limites absolues d'utilisation

P<sub>tot</sub> = 0,25 W / T<sub>amb</sub> = 25 °C d = 4 mm  
 T<sub>j</sub> = - 55 °C - + 150 °C  
 T<sub>stg</sub> = - 55 °C - + 150 °C

Maximum power dissipation  
 Dissipation de puissance maximale



Infinite heat sinks  
 Refroidisseurs infinis



Material : glass  
 Marking : clear, ring at cathode end  
 Matériau : verre

Weight : 0,15 g  
 Masse : 0,15 g Marquage en clair, anneau coté cathode

General characteristics  
 Caractéristiques générales

T<sub>amb</sub> = 25 °C

(Unless otherwise stated)  
 (Sauf indications contraires)

	V <sub>ZT</sub> typ. (V)	r <sub>ZT</sub> max. (Ω)	I <sub>ZT</sub> (mA)	Test temperatures Températures de mesure (°C)	ΔV <sub>Z</sub> max. (V)	αV <sub>Z</sub> (%/°C)
1N 3496	6,2	15	7,5	0 +25 +75	0,024	≈ 0,005
1N 3497	6,2	15	7,5	0 +25 +75	0,010	≈ 0,002
1N 3498	6,2	15	7,5	0 +25 +75	0,005	≈ 0,001
1N 3499	6,2	15	7,5	0 +25 +75	0,002	≈ 0,0005
1N 3500	6,2	15	7,5	0 +25 +75	0,048	≈ 0,01

December 1983 - 1/2

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B P 5  
 F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE  
 Tél (1) 788-50-01 Telex 610560 F

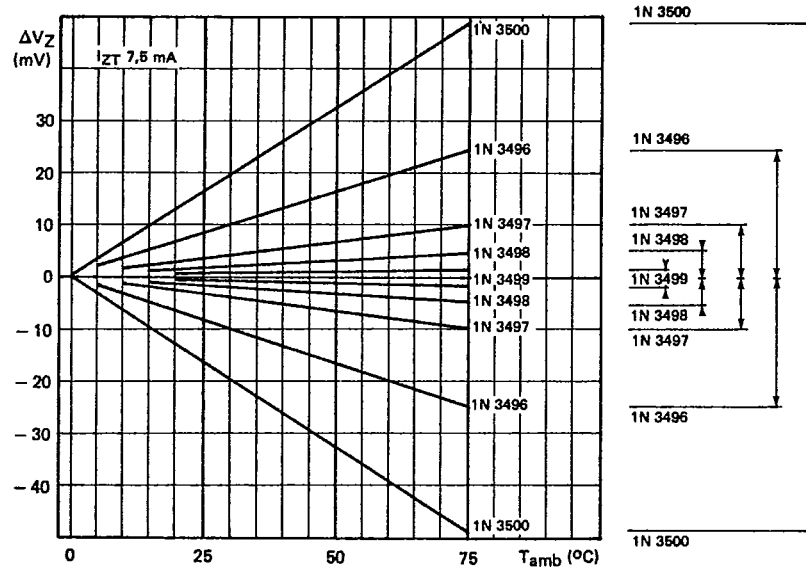


1N 3496 → 1N 3500

59C 02541

D T-11-07

FIGURE 1 1N 3496 → 1N 3500



Regulation voltage variation versus ambient temperature  
 Variation de la tension de régulation en fonction de la température ambiante

**Note**

The voltage reference diodes are characterized by the box method. The maximum allowable voltage change  $\Delta V_Z$  is guaranteed between any two temperatures within the range page 1. Tests are performed at the indicated temperatures and test current.

**Note**

Les diodes de référence de tension sont caractérisées selon la méthode dite « box method ». La variation maximale  $\Delta V_Z$  est garantie entre deux quelconques des températures du domaine indiqué page 1. Des mesures sont effectuées aux températures et au courant spécifiés.